

产品优势 Features

- ◆ 超宽带: 9kHz~30GHz
- ◆ 高隔离: >55dB@全频段,吸收式设计
- ◆ 低插损: <2dB@30GHz
- ◆ 高线性: IP0.1dB 32dBm
- ◆ 供电方式: 支持单、双两种供电
- ◆ 切换时间: 3.6us
- ◆ 封装: LGA 3mmx3mm, 20引脚

典型应用 Applications

- ◆ 5G毫米波通信
- ◆ 测试仪器
- ◆ 卫星通信
- ◆ 微波点对点通信

产品描述 Description

ARW3271L是一款针对30GHz以下应用的高性能吸收式单刀双掷(Absorptive SPDT)硅基射频开关,隔离度在30GHz以内大于55dB,全频段插损低于2dB,输入功率0.1dB压缩点可达32dBm,切换时间3.6us,采用了LGA 3x3mm²封装,引脚兼容ADRF5021,广泛应用于5G毫米波通信、测试仪器、卫星通信、微波点对点通信仪等。

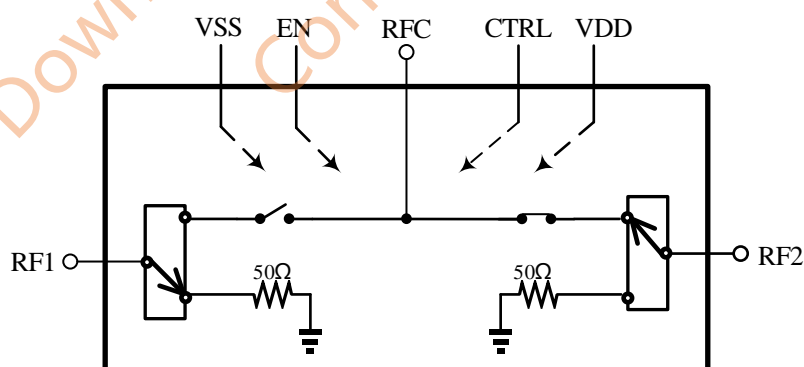


图1 芯片功能框图

交直流特性 AC/DC Electronic Characteristics

表 1 典型值测得的工作条件：芯片外壳温度 25°C, VDD=3.3V, VSS=-2.5V, 50 欧姆测试系统，另有说明除外。

参数/符号		测试条件/备注	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率 Frequency			9kHz		30	GHz
插入损耗 Insertion Loss RFC to RF1/RF2		9kHz~12GHz		1.3		dB
		12~24GHz		1.7		
		24~30GHz		2.0		
隔离度 Isolation RFC to RF1/RF2		9kHz ~12GHz		80		dB
		12~24GHz		70		
		24~30GHz		60		
隔离度 Isolation RF1 to RF2		9kHz ~12GHz		75		dB
		12~24GHz		70		
		24~30GHz		55		
回波损耗 Return Loss RFC/RF1/RF2 ON-State		9kHz ~12GHz		18		dB
		12~24GHz		19		
		24~30GHz		17		
回波损耗 Return Loss RF1/RF2 OFF-State		9kHz ~12GHz		20		dB
		12~24GHz		15		
		24~30GHz		14		
线性度 * Linearity	IP0.1dB	@30MHz		30		dBm
	IP0.1dB	@900MHz		32		
	IIP2	@25dBm 1tone,		96		
	IIP3	@25dBm 1tone,		59		
切换时间 T _{SW}		CTRL 的 50% 到 RF 的 90% 或 10%		3.6		us

*频率低于 1MHz 时，P0.1dB 有退化，IP1dB=15dBm@9kHz。

建议工作范围 Recommended Operating Ranges

表 2

参数/符号	测试条件/备注	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压 V_{DD}		3	3.3	5	V
负电压 V_{SS}		-2.75	-2.5	-2.25	V
电源电流 I_{DD}	@ $V_{DD}=3.3V$, $V_{SS}=0V$;		45	55	μA
	@ $V_{DD}=3.3V$, $V_{SS}=-2.5V$		15	20	
电源电流 I_{SS}	@ $V_{SS}=-2.5V$		17	25	μA
控制电压高电平 V_{INH}		1.2		V_{DD}	V
控制电压低电平 V_{INL}		0		0.6	V
控制电流 I_{INH}/I_{INL}	静态			1	μA
RF1/RF2 端口吸收功率	常温连续波 (RF1/RF2 内部吸收负载)			24	dBm
RFC/RF1/RF2 射频输入功率 P_{IN}	常温连续波 (Through Path), 频率大于 30MHz			30	dBm
工作温度 T_{case}	芯片外壳温度	-40		+85	$^{\circ}C$

绝对极限值 Absolute Maximum Rating

表 3

参数/符号	测试条件/备注	极限值
电源电压 V_{DD} 范围		-0.3~5.5V
负电压 V_{SS} 范围		-3.3~0V
控制电压 V_{CTRL}		-0.3~ $V_{DD}+0.3V$
射频输入功率 P_{IN} 最大值	常温, 连续波	32dBm
存储温度范围		-60~+150 $^{\circ}C$
芯片沟道结温最大值	工作寿命 ≥ 10 年	+125 $^{\circ}C$
防静电等级	HBM 模型	Class 1C

开关控制真值表 Switch Control Truth Table

表 4

控制电压		射频通路	
CTRL	EN	RFC to RF1	RFC to RF2
0	0	OFF	ON
1	0	ON	OFF
0	1	OFF	OFF
1	1	OFF	OFF

“0”低电平, “1”高电平, “ON”射频双向导通, “OFF”射频断开

引脚说明 Pin Configuration and Function Descriptions

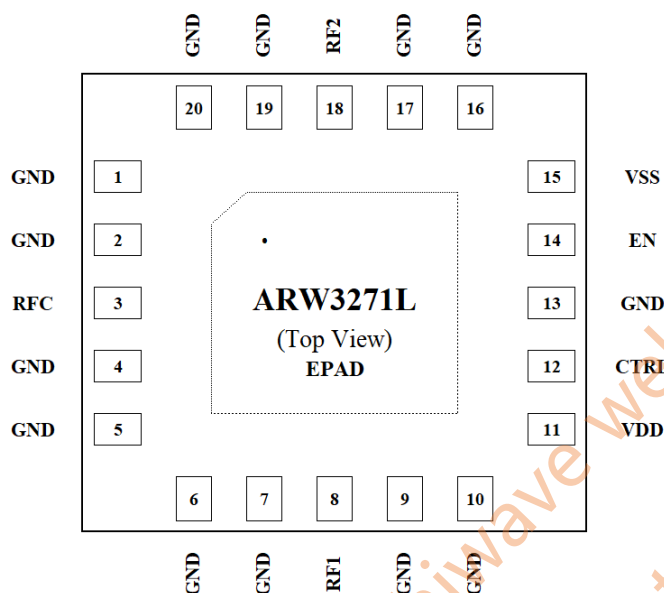


图 2 引脚说明

表 5 引脚功能描述

序号	名称	功能描述	说明
3	RFC	射频端口	射频通道公共端
8	RF1	射频端口	射频通道 1
18	RF2	射频端口	射频通道 2
11	VDD	供电端口	电源供电
12	CTRL	控制信号	控制信号，详见表 4
14	EN	使能信号	使能信号，详见表 4
15*	VSS	供电端口	负压供电或接地
1,2,4,5,6,7,9,10 13,16,17,19,20	GND	接地端	接地
EPAD	EPAD	背面接地焊盘	建议良好接地

备注：

*正负双电源供电或接地单正电源供电的选择，见应用电路中描述。

接口电路

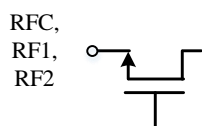


图 3 RFC、RF1、RF2 接口电路

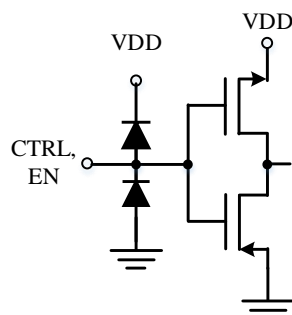


图 4 CTRL、EN 接口电路

典型性能图 Typical Performance Characteristics

曲线来自评估板测试结果，测试条件为：VDD=3.3V，VSS=-2.5V，常温 25℃

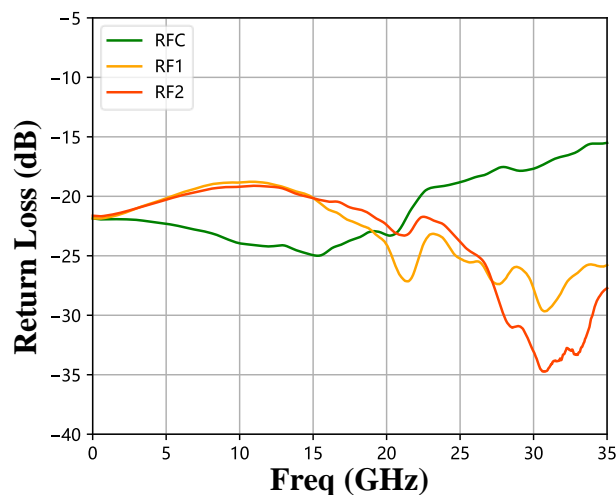


图5 常温，端口导通回波损

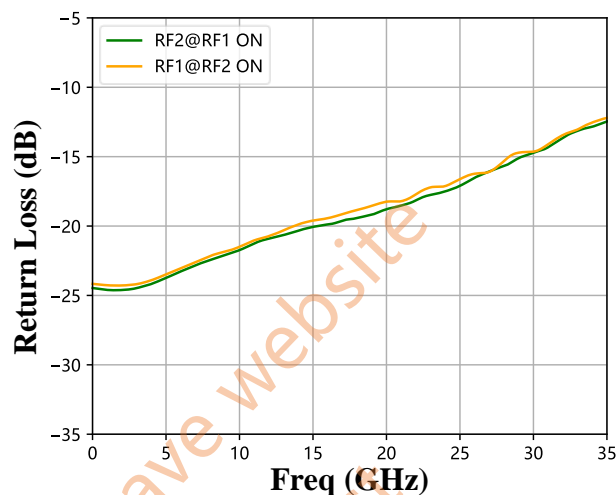


图6 常温，端口关断回波损耗

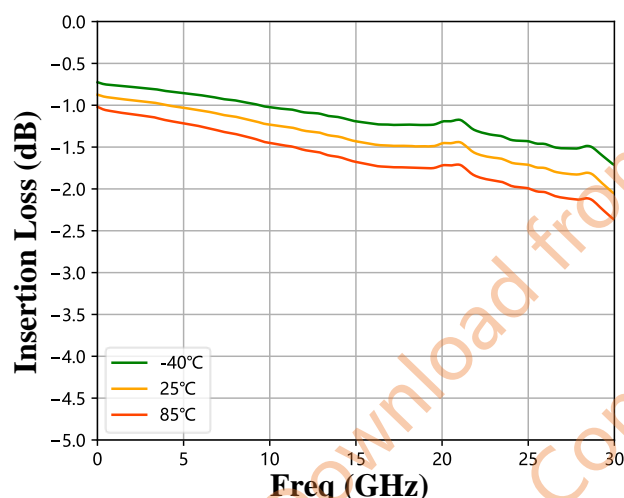


图7 三温，RFC to RF1/RF2插损

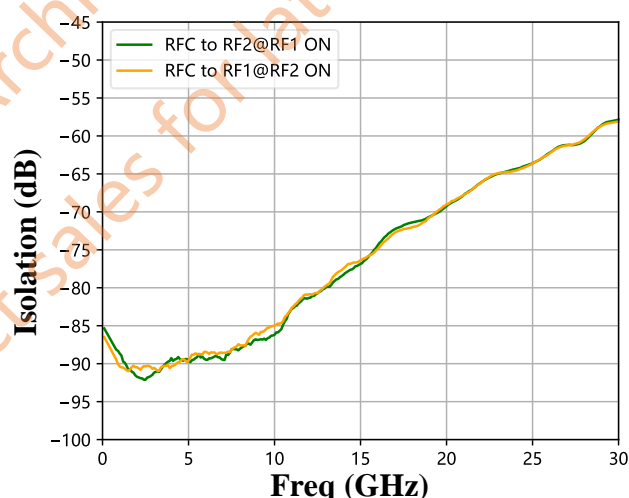


图8 常温，RFC to RF1/2隔离度

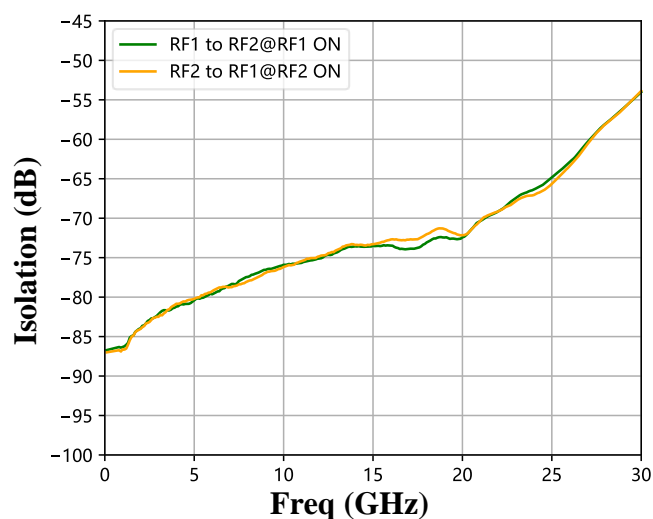


图9 常温，RF1/2 to RF1/2隔离度

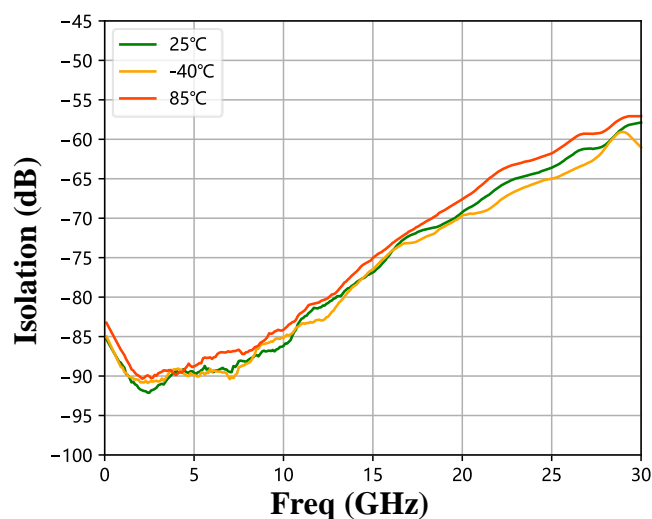


图10 三温，RFC to RF2隔离度@RF1 ON

典型性能图 Typical Performance Characteristics(续)

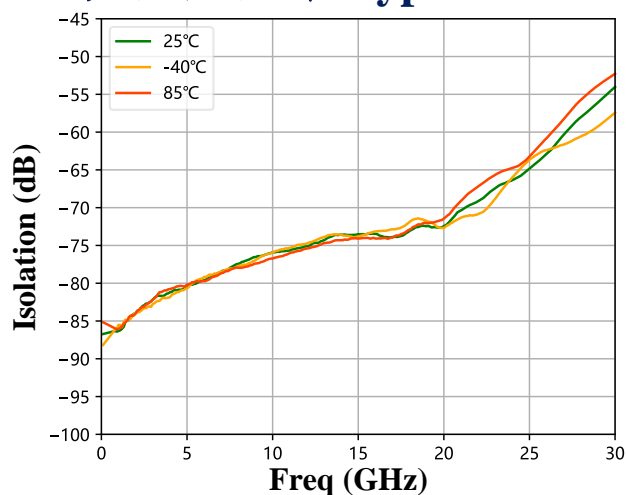


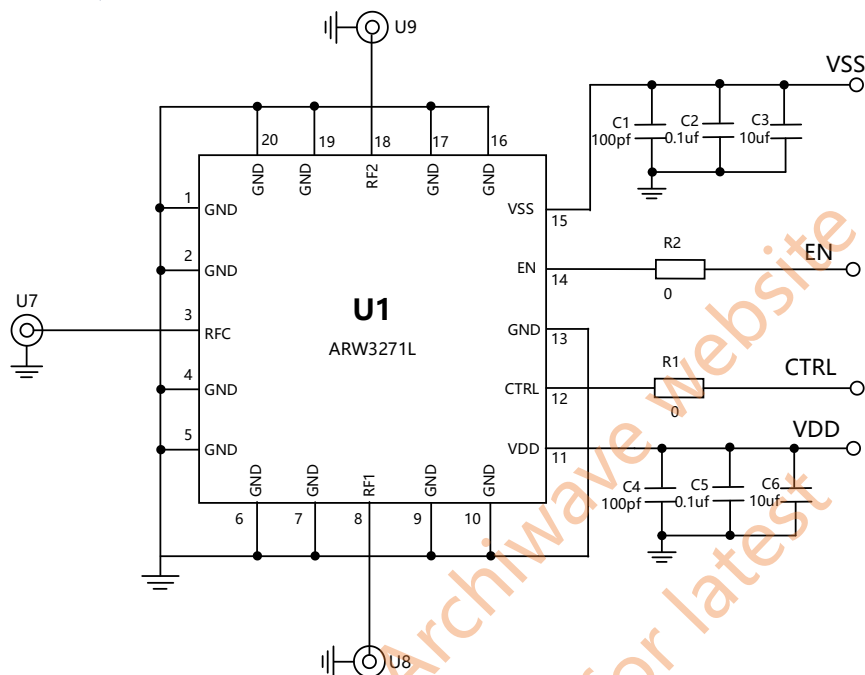
图11 三温，RF1 to RF2隔离度@RF1 ON

*其中插损和回波损耗来自探针测试结果；隔离度采用同轴连接器的评估板测试。

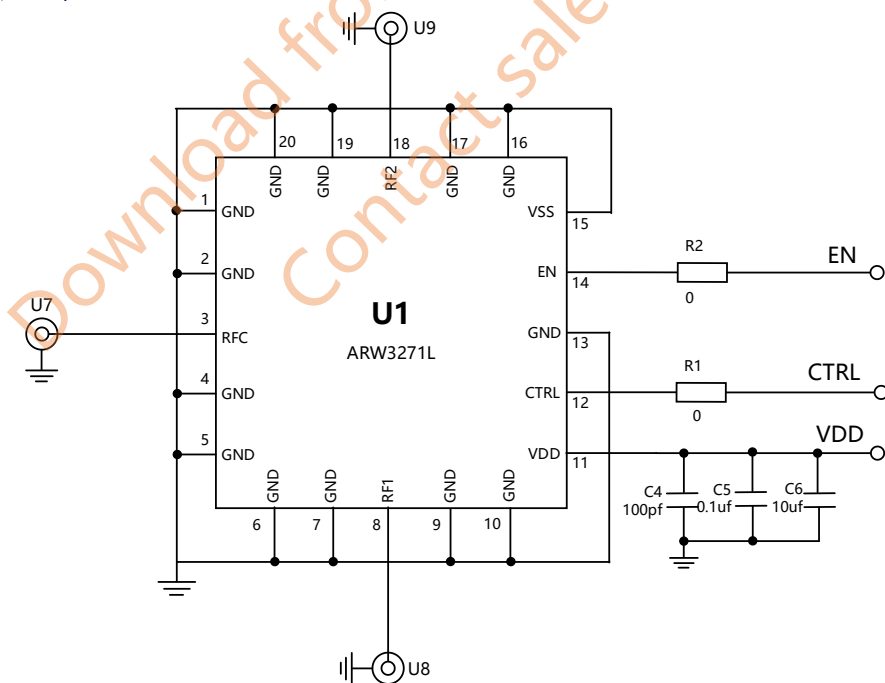
Download from Archiwave website
Contact sales for latest

应用电路 Application Circuit

1. 正负双电源供电应用



2. 单电源供电应用



备注:

1. 芯片射频端口内部无隔直电容。若外部无直流，应用电路中各射频管脚可不加隔直电容；若有直流，需要另外加隔直电容。
2. 单电源供电时，开关最大切换频率 25kHz。单电源供电方式杂散小于-135dBm，双电源供电更小。

图 12 应用电路

封装外形 Package Outline

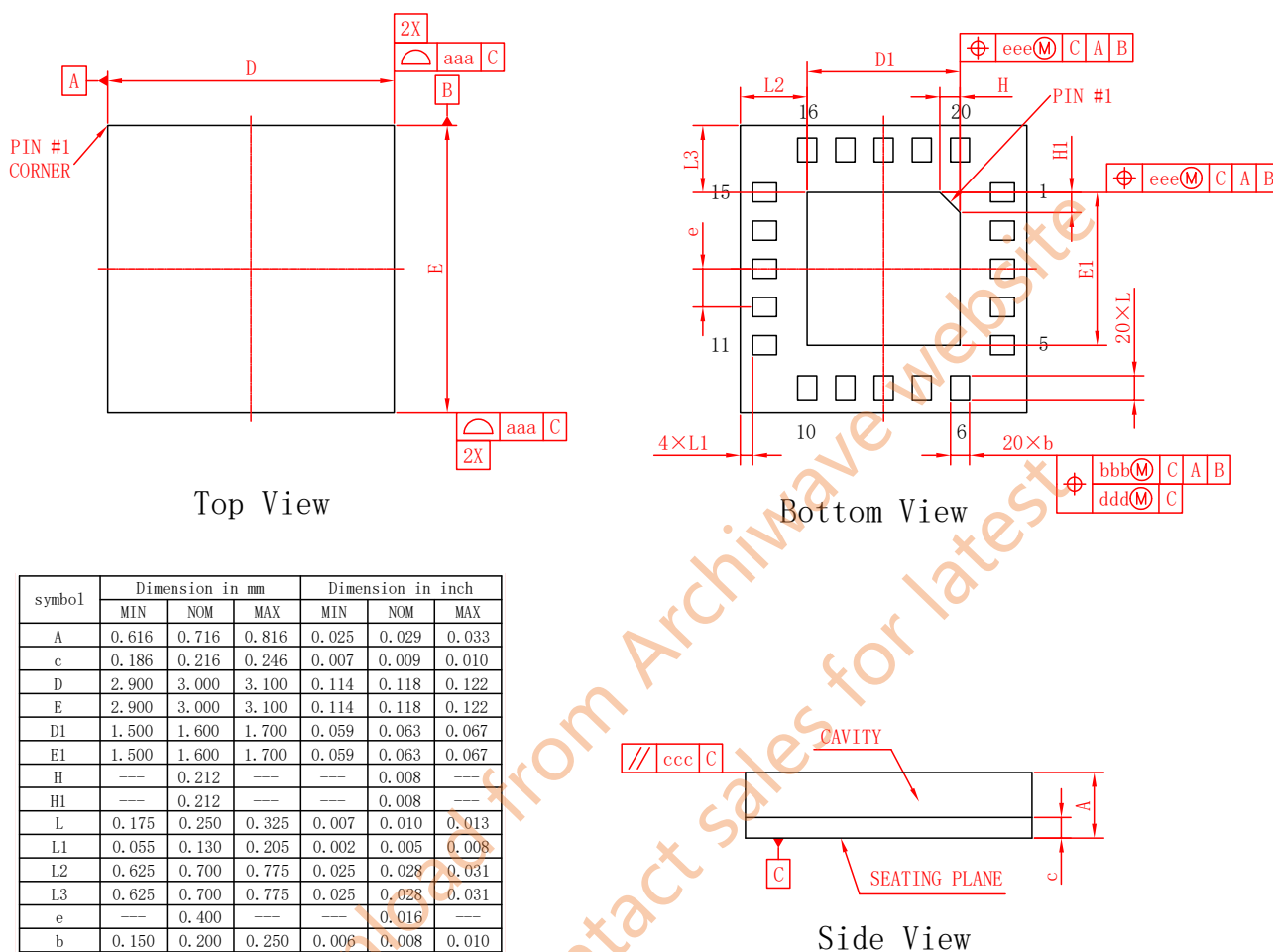


图 14 封装外形图

器件标识 Top Markings

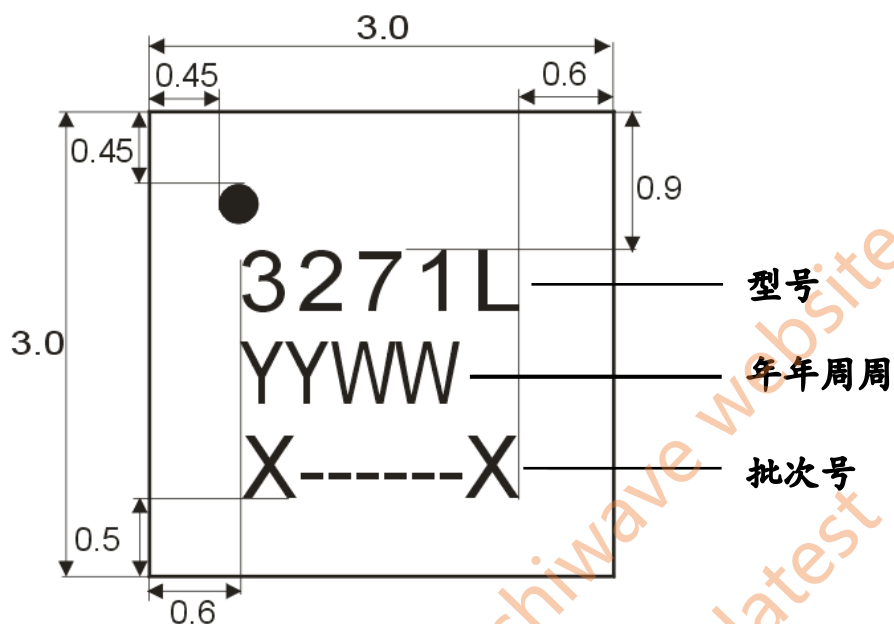


图 15 器件标识

订购信息 Ordering Information

订购码	封装	包装	MSL 等级	说明
ARW3271L	塑封	13 英寸, 3000pcs/Reel	3	

版本修订记录 Revision History

版本*	日期	说明
ES_v0.1	2023-06-06	ARW3271L 工程样品阶段版本发布
Pre_v0.1	2024-01-08	ARW3271L 产品预发布阶段版本发布

Note: *PC、ES、Pre 阶段，产品规格书更新不另作通知。

Download from Archiwave website
Contact sales for latest